

2014年3月24日

「RH850/E1x シリーズ」の主な仕様

	RH850/E1M-S	RH850/E1L
代表型名	R7F701202EABA (tablecolor03A304,320MHz)	R7F701201EAFP (QFP176,240MHz)
メイン CPU	320MHz(with LSDC)	240MHz(with LSDC)
Code Flash	4 MB	2 MB
Data Flash(E2PROM)	64 KB	64 KB
RAM	専用 RAM 64 KB + 共用 RAM 256 KB	専用 RAM 48 KB + 共用 RAM 112 KB
PCU	80MHz/専用 RAM 32KB	
DMA 機能	16 (DMAC) / 128 (DTS)	8 (DMAC) / 128 (DTS)
MPU 領域	12 (CPU) / 4(PCU)	12 (CPU) / 4(PCU)
エンジン・ トランスミッション 制御用タイマ	ATU-IV、APA	ATU-IV、APA
モータ制御用タイマ	TSG2	TSG2
他タイマ機能	WDT:2ch、OSTM:3ch	
シリアル I/F	SCI:4ch、LIN:1ch、	
CSIH	4ch	3ch
マイクロセカンドバス I/F	RHSB:2ch	RHSB:1ch
CAN	RSCAN:4ch	
ADC SAR AD/ $\Delta\Sigma$ AD	24+24ch / 8ch	24ch+16ch / 2ch
動作電圧	5/3.3/1.25V (外部パストランジスタ使用時は 5/3.3V)	
他周辺機能	セーフティ機能(エラーコントロールモジュール、CRC、MISR、コア電圧検出回路)、 セキュリティ機能(IFS)、デジタルフィルタエンジン(DFE)	
パッケージ	304ピン P- tablecolor03A(19mm × 19mm) 252ピン P- tablecolor03A(17mm × 17mm)	252ピン P- tablecolor03A(17mm × 17mm) 176ピン P- LQFP(24mm × 24mm)

		144ピン P- LQFP(21mm×21mm)
--	--	-----------------------------

「RAA270000KFT」の主な仕様

項目	仕様
製品名	RAA270000KFT
構成	・降圧スイッチングレギュレータ 2 系統、LDO (注 1) 4 系統、トラッカ 2 系統
	・出力パワーMOSFET (注 2) 内蔵
	・低電圧/過電圧/過電流/過熱検知機能内蔵
	・パワーオン/オフ シーケンサ機能、リセット生成機能、ウォッチドッグ機能内蔵
	・内部アナログ信号出力機能、SPI スレーブ通信機能内蔵
入力電圧	5.4V~26V, 40V(400msec)
出力電圧/最大出力電流	スイッチングレギュレータ : 5.7V/1000mA, 1.25V/700mA
	LDO : 5V/300mA, 5V/60mA, 3.3V/160mA, 3.3V/10mA
スイッチング周波数	スイッチングレギュレータ : 2.1MHz
動作周囲温度	-40°C~125°C
パッケージ	HTQFP 64 ピン(12.0mm X 12.0mm X 1.2mm、0.5mm ピンピッチ)

(注 1) LDO は Low-Drop-Out regulator (低損失レギュレータ) の略。

(注 2) MOSFET は Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor (金属酸化膜半導体 電界効果トランジスタ) の略。

以上

* 本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。